

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 12 月 14 日 (2006.12.14)

【公表番号】特表 2006-504784 (P2006-504784A)

【公表日】平成 18 年 2 月 9 日 (2006.2.9)

【年通号数】公開・登録公報 2006-006

【出願番号】特願 2004-550038 (P2004-550038)

【国際特許分類】

C 0 7 C 2/86 (2006.01)

B 0 1 J 29/70 (2006.01)

C 0 7 B 35/08 (2006.01)

C 0 7 B 37/04 (2006.01)

C 0 7 C 5/27 (2006.01)

C 0 7 C 15/073 (2006.01)

C 0 7 C 15/08 (2006.01)

C 0 7 B 61/00 (2006.01)

【F I】

C 0 7 C 2/86

B 0 1 J 29/70 Z

C 0 7 B 35/08

C 0 7 B 37/04 C

C 0 7 C 5/27

C 0 7 C 15/073

C 0 7 C 15/08

C 0 7 B 61/00 3 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 10 月 17 日 (2006.10.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

芳香族化合物の転化に適した原料を、転化条件の下で、3 次元のチャネル系を有する多孔性の合成結晶材料を含む触媒と接触させる工程を含むプロセスであって、この 3 次元チャネル系が、それぞれが四面体に配位された原子の 10 員環によって規定される全体として平行な第 1 組のチャネル群と、同じく四面体配位原子の 10 員環によって規定されかつ前記第 1 組のチャネル群と交差する全体として平行な第 2 組のチャネル群と、前記第 1 組及び前記第 2 組のチャネル群と交差するチャネル群であって、それぞれが四面体配位原子の 9 員環によって規定される全体として平行な第 3 組のチャネル群とを含んでいるプロセス。

【請求項 2】

前記多孔性合成結晶材料が、酸素原子によって架橋された四面体状原子の骨格構造を備えており、この四面体状原子の骨格構造は、下記の表 1 に示すナノメータの原子座標を有する単位セルによって規定され、各座標位置は  $\pm 0.05$  ナノメータの範囲内で変化することがある、請求項 1 記載のプロセス。

【表 1】

表 1			
T1	0.626	0.159	0.794
T2	0.151	0.151	0.478
T3	0.385	0.287	0.333
T4	0.626	0.158	0.487
T5	0.153	0.149	0.781
T6	0.383	0.250	1.993
T7	0.473	0.153	0.071
T8	0.469	0.000	1.509
T9	0.466	0.000	1.820
T10	0.626	0.979	0.794
T11	1.100	0.987	0.478
T12	0.867	0.851	0.333
T13	0.626	0.980	0.487
T14	1.099	0.989	0.781
T15	0.869	0.888	1.993
T16	0.778	0.985	0.071
T17	0.783	0.000	1.509
T18	0.785	0.000	1.820
T19	0.151	0.987	0.478
T20	0.385	0.851	0.333
T21	0.153	0.989	0.781
T22	0.383	0.888	1.993
T23	0.473	0.985	0.071
T24	1.100	0.151	0.478
T25	0.867	0.287	0.333
T26	1.099	0.149	0.781
T27	0.869	0.250	1.993
T28	0.778	0.153	0.071
T29	0.626	0.728	1.895
T30	0.151	0.720	1.579
T31	0.385	0.856	1.433
T32	0.626	0.727	1.588
T33	0.153	0.718	1.882
T34	0.383	0.819	0.893
T35	0.473	0.722	1.171
T36	0.469	0.569	0.409
T37	0.466	0.569	0.719
T38	0.626	0.410	1.895
T39	1.100	0.418	1.579
T40	0.867	0.282	1.433
T41	0.626	0.411	1.588
T42	1.099	0.420	1.882
T43	0.869	0.319	0.893
T44	0.778	0.416	1.171
T45	0.783	0.569	0.409
T46	0.785	0.569	0.719
T47	0.151	0.418	1.579
T48	0.385	0.282	1.433
T49	0.153	0.420	1.882
T50	0.383	0.319	0.893
T51	0.473	0.416	1.171
T52	1.100	0.720	1.579
T53	0.867	0.856	1.433
T54	1.099	0.718	1.882
T55	0.869	0.819	0.893
T56	0.778	0.722	1.171

## 【請求項 3】

前記多孔性合成結晶材料が、下記の表 2 に実質的に記載されているような d - 間隔と相対

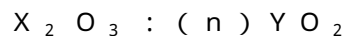
強度値とを含む X 線回折パターンを有する、請求項 1 または 2 記載のプロセス。

【表 2】

表 2	
d(Å)	相対強度 (I)
12.46 ± 0.2	w-vs
10.97 ± 0.2	m-vs
10.12 ± 0.2	vw-w
8.25 ± 0.2	vw
7.87 ± 0.2	w-vs
5.50 ± 0.15	w-m
5.45 ± 0.15	vw
5.32 ± 0.15	vw-w
4.70 ± 0.15	vw
4.22 ± 0.15	w-m
4.18 ± 0.15	vw-w
4.14 ± 0.15	w
3.97 ± 0.1	w
3.90 ± 0.1	vw-m
3.86 ± 0.1	m-vs
3.73 ± 0.1	m-vs
3.66 ± 0.1	m-s

【請求項 4】

前記多孔性合成結晶材料が、次式：



のモル数の関係を含む組成を有し、式中、n は少なくとも約 5 であり、X は 3 価の元素、Y は 4 価の元素である、請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項記載のプロセス。

【請求項 5】

前記 X が、ホウ素、鉄、インジウム、ガリウム、アルミニウム、及び、これらの組み合わせからなる群から選定された 3 価の元素であり、前記 Y が、ケイ素、スズ、チタン、ゲルマニウム、及び、これらの組み合わせからなる群から選定された 4 価の元素である、請求項 4 記載のプロセス。

【請求項 6】

前記 X がホウ素またはアルミニウムを含み、前記 Y がケイ素を含む、請求項 5 記載のプロセス。

【請求項 7】

前記 X がアルミニウムである、請求項 6 記載のプロセス。

【請求項 8】

前記多孔性合成結晶材料のシリカ対アルミナのモル比が 1 0 0 0 未満である、請求項 7 記載のプロセス。

【請求項 9】

前記触媒が少なくとも 1 つの水素化 / 脱水素金属をさらに含む、請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項記載のプロセス。

【請求項 10】

前記少なくとも 1 つの水素化 / 脱水素金属が第 V I I I 族の金属及び第 V I I B 族の金属からなる群から選定される、請求項 9 記載のプロセス。